Ingénierie Physique et Valorisation

ECTS

Volume horaire
72h

Présentation

Description

Cours Hyperfréquence / CEM / Analyse de défaillance

-Description de la compatibilité électromagnétique des équipements, le durcissement des systèmes contre des agressions (foudre, champs forts, impulsion électromagnétique nucléaire, etc...) les menaces, les phénomènes de couplage, techniques de protection.

- Fondamentaux (propagation) / Fonctions principales hyperfréquences (lignes planaires et coupleurs, amplificateurs, atténuateurs, déphaseur, oscillateurs, mélangeurs) / Composants actifs hyperfréquences (semi-conducteurs, transistors, MMICs, oscillateurs) / Applications dans les satellites

- Cours de CultureS nano
Le cours "Culture(S) Nano" est une expérimentation pédagogique visant à engager les élèves ingénieurs à analyser les enjeux des Nanotechnologies et au-delà les enjeux de la science au 21ième siècle. Le but est d'identifier l'existence d'une "Culture Nano" dominante et d'en percevoir les spécificités. Au-delà de l'exemple de départ des Nanotechnologies l'objectif visé est une réflexion sur la culture scientifique à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Une série d'activités individuelles et en groupe est mise en place afin d'engager les élèves vers la découverte de cultures scientifiques alternatives. Le travail est mis en pratique dans la conception d¿un projet scientifique qui fait sens pour les élèves. L'élève ingénieur développe par cette démarche une pensée critique et articule son futur métier et ses valeurs éthiques à la recherche d'une cohérence personnelle.

- Cours Plasma
Présentation générale des procédés assistés par plasma froid – Notion de décharge électrique dans un gaz - Décharge continue - Décharges radiofréquence - Mécanismes réactionnels dans les plasmas - Procédés de dépôt assistés par plasma (PECVD) - Gravures sèches

- Cours Tech. Matériaux nouveaux
Les alliages Si-Ge-C : structure, pps électriques, applications, intégration composants
Le SiC : structure, pps électriques, applications, intégration composants
Le SOI : fabrication, applications
Les nanocristaux de Si : mémoires et opto-électronique

- Valorisation
Politique de brevet et entreprenariat

Objectifs

Les multiples objectifs sont les suivants :

- Être capable de décrire l'architecture de base d'une charge utile de Télécommunication en comprenant la description fonctionnelle d'un transpondeur de type « bent-pipe »
- Acquérir une connaissance approfondie de chaque équipement RF composant la charge utile d'un satellite de télécommunication (Spécifications, drivers, technologies et les points clés associés
- Avoir compris et pouvoir expliquer les technologies et

Informations non contractuelles

matériaux nouveaux de la microélectronique (SiGe, SiC, III-V, SOI, OLED...)
- Acquérir des connaissances de base dans le domaine des plasmas et leur utilisation
- Acquérir des notions sur la compatibilité électromagnétique et l'analyse de défaillance
- Développer une réflexion personnelle sur l'impact de la science sur la société en relation avec les changements environnementaux
- Analyser et critiquer la nature de la science et de la technologie
- Construire un projet de recherche ayant du sens par rapport à ses valeurs personnelles et les grands défis sociétaux.

Pré-requis nécéssaires

- Cours sur les "semiconducteurs" donné en 3IMACS.
- Manipulation des grandeurs en décibel
- Connaissances pratiques en thermodynamique du solide et métallurgie physique
- Notions de RF (bruit, gain) d'électromagnétisme

Évaluation

L'évaluation des acquis d'apprentissage est réalisée en continu tout le long du semestre. En fonction des enseignements, elle peut prendre différentes formes : examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit, évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)

Toulouse